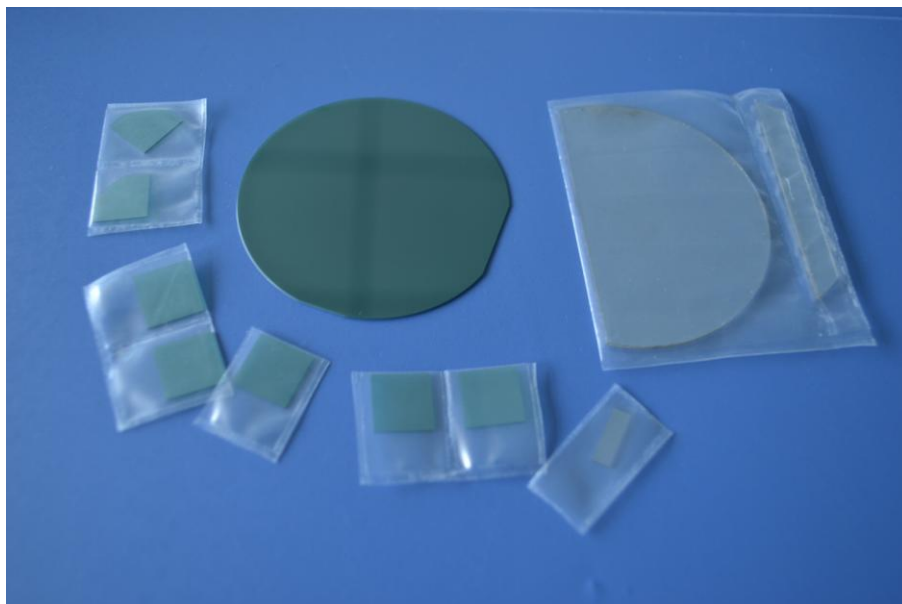




SiC



主要性能参数	
生长方法	MOCVD
晶体结构	六方
晶格常数	$a=3.08 \text{ \AA}$ $c=15.08 \text{ \AA}$
排列次序	ABCACB
方向	生长轴或 偏 $\langle 0001 \rangle$ 3.5°
带隙	2.93 eV (间接)
硬度	9.2 (Mohs)
热传导@300K	5 W/ cm.k
介电常数	$\epsilon(11)=\epsilon(22)=9.66$ $\epsilon(33)=10.33$
尺寸	10x3, 10x5, 10x10, 15x15, , 20x15, 20x20,
	dia2" x 0.33mm dia2" x 0.43mm 15 x 15 mm
厚度	0.5mm, 1.0mm
抛光	单面或双面
晶向	$\langle 001 \rangle \pm 0.5^\circ$
晶面定向精度:	$\pm 0.5^\circ$
边缘定向精度:	2° (特殊要求可达 1° 以内)
斜切晶片	可按特定需求, 加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜 (倾斜角 $1^\circ - 45^\circ$) 的晶片
Ra:	$\leq 5 \text{ \AA}$ ($5 \mu\text{m} \times 5 \mu\text{m}$)
包装	100 级洁净袋, 1000 级超净室

电话 :021-69918486, 69918652, E-mail:gzhchen@siom.ac.cn;sales@sgcrystal.com

网址 :www.sgcrystal.com